

К. ф.-м. н. А. В. РЫБКА, А. А. ЗАХАРЧЕНКО, к. ф.-м. н. Л. Н. ДАВЫДОВ,  
И. Н. ШЛЯХОВ, А. А. БЛИНКИН, К. В. КУТНИЙ

Украина, ННЦ "Харьковский физико-технический институт"  
E-mail: rybka@kipt.kharkov.ua

Дата поступления в редакцию  
13.12.2005 г.

Оппонент д. т. н. В. К. КОМАРЬ  
(Ин-т монокристаллов, г. Харьков)

## СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ CdZnTe ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

*На основе CdZnTe можно с успехом создавать дозиметрические и спектрометрические измерительные приборы, работающие при комнатной (и близких к ней) температуре.*

Дозиметрические и спектрометрические приборы с сенсорами из полупроводниковых кристаллов CdZnTe (CdTe) в последнее время находят все более широкое применение при регистрации ионизирующего излучения, как рентгеновского, так и гамма-излучения [1]. Благодаря широкой запрещенной зоне (1,6 эВ для CdZnTe) и совершенствованию технологии производства создаются кристаллы с необходимыми, а в некоторых случаях уникальными, физическими свойствами, что позволяет получать на их основе блоки детектирования с хорошими спектрометрическими и эксплуатационными характеристиками. Они отличаются высокой эффективностью регистрации излучения, хорошим соотношением сигнал/шум и энергетическим разрешением при комнатной температуре. Линейность в счетном и токовом режимах работы в широком диапазоне измеряемой мощности дозы и высокая радиационная стойкость CdZnTe [2] позволяют использовать его при производстве дозиметрических блоков с высоким радиационным ресурсом, в частности, для работы в радиационных полях большой интенсивности. Это определяет все более перспективное использование сенсоров на основе CdZnTe (CdTe) как в системах дозиметрического контроля (например, на АЭС, на предприятиях по производству и переработке ядерного топлива, при экологическом контроле), так и в спектрометрических системах (например, для анализа радиоактивных отходов, в ядерно-физических методах элементного анализа и др.).

В настоящей работе приведены результаты испытаний двух блоков детектирования — рентгеновского дозиметра, который в токовом режиме способен работать в широком диапазоне мощности экспозиционных доз, и рентгеновского спектрометра. Используемые в них сенсоры из CdZnTe, в отличие от традиционно используемых полупроводниковых сенсоров, не требуют криогенного охлаждения.

### Контроль мощности дозы рентгеновского излучения

Для измерения большой мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения был разработан

и создан блок детектирования (БД), который работает в токовом (аналоговом) режиме. Такой БД включает в себя сенсор из CdZnTe и преобразователь "ток—напряжение" (рис. 1). Измерительный тракт, кроме БД, содержит еще блок нормирующих усилителей, универсальный вольтметр и блок питания (на рисунке не показаны). БД может при необходимости помещаться на удалении от блока нормирующих усилителей, будучи соединенным с ним кабельным каналом связи.



Рис. 1. Блок детектирования для контроля мощности дозы рентгеновского излучения

В аналоговом режиме работы ток, возникающий в результате воздействия кванта излучения на сенсор, поступает на преобразователь "ток—напряжение" с коэффициентом преобразования  $\approx 1$  мкА/В. На выходе прибора возникает напряжение, пропорциональное мощности экспозиционной дозы (МЭД). Как показали испытания, сигналы сенсора можно передавать по кабельным каналам связи на расстояния до 50 м.

С целью выяснения работоспособности сенсора из CdZnTe в рентгеновских полях высокой интенсивности с помощью описываемого блока детектирования были проведены измерения МЭД на технологической рентгеновской установке (трубка с молибденовым анодом). Для этого в корпусе БД было сделано специальное окно из бериллиевой фольги. Это позволило регистрировать рентгеновское излучение в диапазоне энергий, начиная с  $\approx 5$  кэВ.

На подготовительном этапе работы была проведена калибровка технологической рентгеновской установки ДРОН-4 для измерения МЭД в зависимости от режима работы рентгеновской трубки. В дальнейшем установка служила источником рентгеновского излучения при испытании БД. Калибровка проводилась поверенным медицинским дозиметром фирмы VEB RFT 27 012 в точке, удаленной на 150 мм от источ-

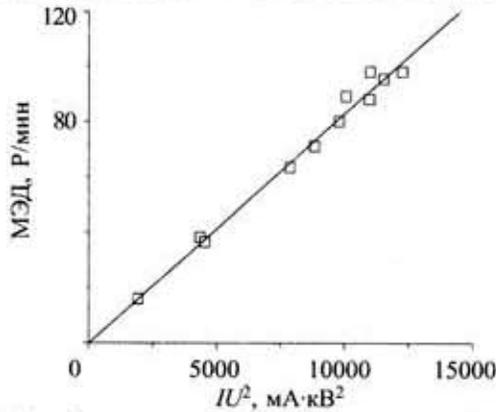


Рис. 2. Калибровочная зависимость рентгеновской установки, полученная с помощью дозиметра RFT 27 012 ника (рис. 2). Полная мощность излучения ( $W_p$ ) непрерывного рентгеновского спектра определялась как [3, с. 11]

$$W_p = kZIU^2,$$

где  $k$  — калибровочная постоянная;  
 $Z$  — атомный номер материала анода;  
 $I$  — ток, протекающий через рентгеновскую трубку;  
 $U$  — напряжение на трубке.

Отсюда следует пропорциональность МЭД произведению  $I \cdot U^2$ .

Калибровочная зависимость на рис. 2 позволяет определить коэффициент пропорциональности, равный  $kZ=0,0083$  (Р/мин)/(МА·КВ<sup>2</sup>) для пересчета произведения  $IU^2$  на рентгеновской трубке в мощность экспозиционной дозы ( $Z_{Mo}=42$ ).

Зависимость от МЭД величины тока, создаваемого БД для контроля мощности дозы с сенсором из CdZnTe, представлена на рис. 3 для разных значений напряжения смещения. Видно, что эта зависимость имеет линейный характер.

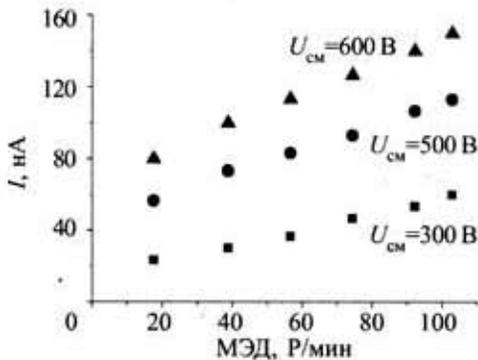


Рис. 3. Дозовая зависимость тока в блоке детектирования для контроля мощности дозы с сенсором из CdZnTe при разных напряжениях смещения

Для сравнения на рис. 4 показана аналогичная зависимость описываемого БД, в котором вместо сенсора из CdZnTe был установлен сенсор из CdTe. Эту зависимость также с достаточной точностью можно считать линейной. Основное отличие в том, что сенсор из CdZnTe вырабатывает при той же МЭД меньший ток, что коррелирует с его более высоким удельным сопротивлением. Это позволяет БД с CdZnTe

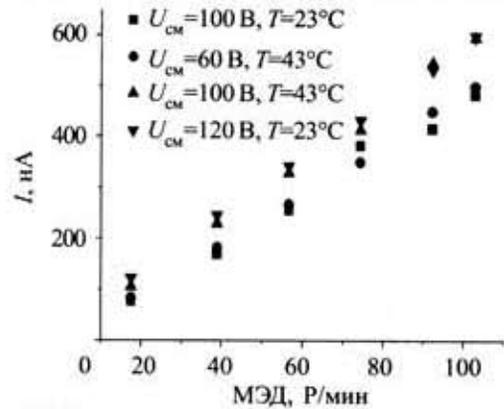


Рис. 4. Дозовая зависимость тока в БД с сенсором из CdTe при разных температурах и напряжениях смещения сохранять работоспособность при большей интенсивности излучения, чем БД с CdTe.

Непосредственное сравнение токов в БД с CdTe и CdZnTe в зависимости от МЭД при  $U_{см}=120$  В приведено на рис. 5.

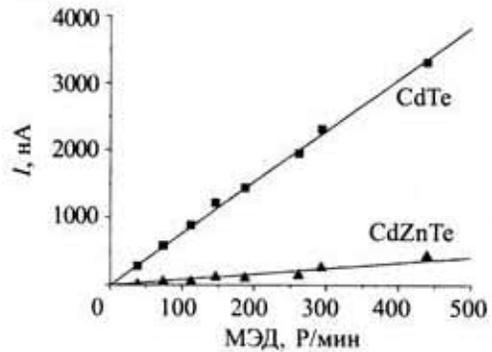


Рис. 5. Сравнение дозовых зависимостей токов БД с сенсорами из CdTe и CdZnTe при  $U_{см}=120$  В

Таким образом, разработанный БД для контроля больших мощностей доз рентгеновского излучения в токовом режиме измерения может регистрировать рентгеновское излучение с энергией от 5 кэВ в широком интервале значений мощности экспозиционных доз, вплоть до аварийных уровней излучения (практически до 450 Р/мин и более).

### Спектрометрия рентгеновского излучения

Основной задачей, которая ставилась при разработке спектрометрического блока детектирования, являлось улучшение его энергетического разрешения в рентгеновском диапазоне энергий. Энергетическое разрешение спектрометра ионизирующего излучения с полупроводниковым сенсором определяется рядом параметров. Это, прежде всего, эффективность собирания носителей заряда, возникающих при взаимодействии излучения с сенсором. Эта эффективность зависит как от качества материала сенсора (время жизни и подвижность носителей заряда, степень дефектности кристалла), так и от приложенного к сенсору напряжения. Важным фактором, вносящим существенный вклад в величину энергетического разрешения, является также электрический шум системы "сенсор—предусилитель". Эти особенности были учтены при разработке спектрометри-

ческого блока детектирования рентгеновского излучения.

Конструктивно спектрометрический БД состоит из CdZnTe-сенсора, предварительного усилителя и термостабилизатора. Для ввода излучения корпус БД снабжен тонким (20 мкм) Ве-окном. Измерительный тракт состоит также из блока усилителя-формирователя и компьютера (рис. 6).



Рис. 6. Спектрометр рентгеновского излучения

Измерительный тракт спектрометра был выполнен с использованием элементной базы фирмы Analog Devices. Сигнал с CdZnTe-сенсора поступал на предварительный усилитель. С предусилителя импульсы поступают в блок усилителя-формирователя, содержащий сам усилитель-формирователь, АЦП и блок питания всего прибора. После цифровой обработки при помощи 12-разрядного АЦП сигнал поступал в компьютер.

Для исключения шумового вклада входной разделительной емкости в данной конструкции БД сенсор подключен непосредственно к затвору транзистора первого каскада предусилителя. Конструкция прибора позволяла установку полупроводниковых CdZnTe-сенсоров разных размеров, а также сенсоров из CdTe. Кроме того, БД был оснащен устройством термостабилизации (на эффекте Пельтье), позволяющим поддерживать температуру сенсора в диапазоне  $-30...+30^{\circ}\text{C}$ .

Небольшие габариты (30×40×35 мм) и возможность размещения БД на удалении от усилителя-формирователя (до 10 м) позволяют применять спектрометр вместе с дистанционно управляемыми манипуляторами, например, для анализа радиоактивных отходов в труднодоступных местах либо в условиях высоких уровней рентгеновского излучения.

Спектры, иллюстрирующие работу спектрометра в рентгеновском диапазоне энергий, приведены на рис. 7—9. Отметим сразу, что приведенные спектры получены без электронной коррекции сигнала и без математической обработки результатов измерений, что позволяет дополнительно улучшить энергетическое разрешение прибора.

На рис. 7 представлен типичный спектр источника  $^{241}\text{Am}$  из набора образцовых спектрометрических источников гамма-излучения (ОСГИ), измеренный в диапазоне энергий 10...60 кэВ при  $+27^{\circ}\text{C}$  с помощью спектрометрического БД с сенсором из CdZnTe размерами 5×5×2 мм. Время набора 30 с, расстояние до источника 1 см. Энергетическое разрешение составляет  $\approx 14\%$  на линии 60 кэВ.

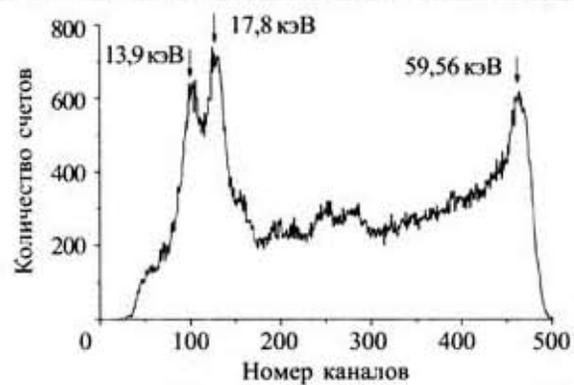


Рис. 7. Спектр  $^{241}\text{Am}$ , полученный сенсором из CdZnTe

Мы видим, что полупроводниковые кристаллы CdZnTe, которые хорошо зарекомендовали себя в качестве материала для спектрометрических сенсоров гамма-излучения в диапазоне нескольких сотен кэВ, являются чувствительными сенсорами в рентгеновском диапазоне энергий, обеспечивая удовлетворительное энергетическое разрешение даже при работе сенсора без охлаждения. Дополнительное охлаждение сенсора с помощью термостабилизатора на эффекте Пельтье позволяет повысить спектрометрическое разрешение прибора.

Низкоэнергетический спектр радионуклидов  $^{55}\text{Fe}$  и  $^{241}\text{Am}$ , полученный спектрометрическим БД с CdZnTe-сенсором размерами 5×5×0,5 мм, охлажденным до  $-30^{\circ}\text{C}$ , показан на рис. 8.

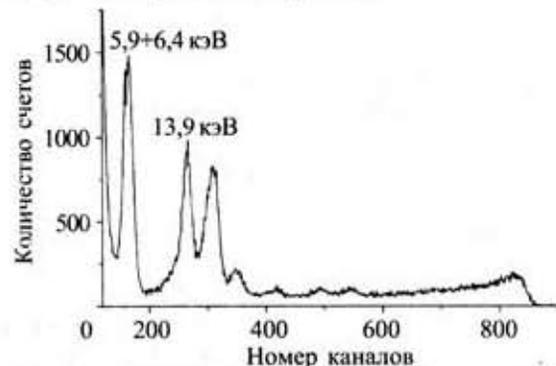


Рис. 8. Низкоэнергетический спектр радионуклидов  $^{55}\text{Fe}$  и  $^{241}\text{Am}$ , полученный БД с CdZnTe-сенсором толщиной 0,5 мм, охлажденным до  $-30^{\circ}\text{C}$

Понижение температуры до  $-30^{\circ}\text{C}$  приводит к разделению линий 13,9 кэВ (разрешение 7,6%) и 17,8 кэВ (разрешение 9,1%), а также появлению линии 5,9+6,4 кэВ ( $^{55}\text{Fe}$ , разрешение  $\approx 12\%$ ). В процессе измерений входной полевой транзистор предусилителя не охлаждался; не изменялись при охлаждении параметры цепей обработки сигнала и напряжения смещения сенсора (40 В).

С помощью спектрометрического БД с CdZnTe-сенсором имеется возможность регистрировать низкоэнергетические  $\gamma$ -кванты в рентгеновском диапазоне на фоне интенсивных (0,5 Р/ч) потоков высокоэнергетических  $\gamma$ -квантов. На рис. 9 показан спектр  $^{99\text{m}}\text{Tc}$  (дочернего ядра изотопа  $^{99}\text{Mo}$ ), полученный CdZnTe-сенсором (5×5×1 мм) при комнатной температуре. Высокоэнергетическая часть фона активированной

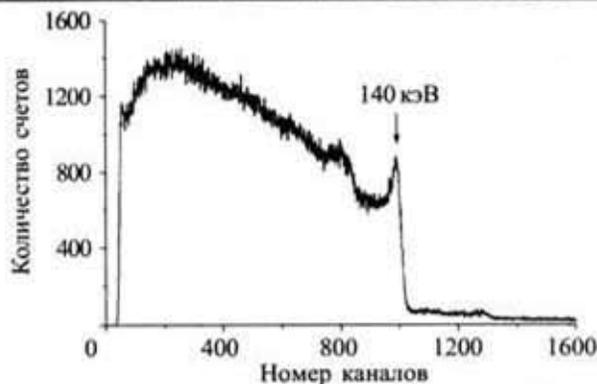


Рис. 9. Спектр активированной мишени  $^{99}\text{Mo}$  ( $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ), полученный CdZnTe-детектором ( $5 \times 5 \times 1$  мм) при комнатной температуре. Использовался фильтр из Cu толщиной 0,5 мм

мишени  $^{99}\text{Mo}$ , образованная  $\gamma$ -квантами с энергиями до 800 кэВ и  $\beta$ -частицами, практически не регистрируется за счет небольшой толщины кристалла сенсора (1 мм). Понятно, что чем выше энергия фона, тем меньше оказывается ее вклад.

**Выводы**

Результаты работы подтверждают, что CdZnTe является хорошим материалом для сенсоров рентге-

новского излучения. На его основе можно с успехом создавать дозиметрические и спектрометрические измерительные приборы, работающие при комнатной (и близких к ней) температуре.

Дозиметр для контроля больших мощностей доз рентгеновского излучения в токовом режиме измерения может регистрировать рентгеновское излучение с энергией от 5 кэВ в широком интервале мощности экспозиционных доз, вплоть до аварийных уровней излучения (практически до 450 Р/мин и более).

Спектрометр рентгеновского излучения на основе сенсора из CdZnTe может применяться для спектроскопии рентгеновского излучения в диапазоне энергий от 5 кэВ, в частности для анализа состава радионуклидов в этом диапазоне.

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ**

1. Rybka A. V., Davydov L. N., Shlyakhov I. N. et al. Gamma-radiation dosimetry with semiconductor CdTe and CdZnTe detectors // Nucl. Instr. and Meth.— 2004.— Vol. 531, N 1–2.— P. 147–156.
2. Давыдов Л. Н., Захарченко А. А., Кутний Д. В. и др. Радиационная стойкость полупроводниковых детекторов корпускулярного и гамма-излучения (обзор) // Вісник ХНУ. Сер. „Ядра, частинки, поля”.— 2005.— № 627.— С. 3–22.
3. Русаков А. А. Рентгенография металлов.— М.: Атомиздат, 1977.

**ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ**



**СЕНСОРА ЕЛЕКТРОНІКА  
ТА МІКРОСИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
SENSORS ELECTRONICS  
AND MICROSYSTEM TECHNOLOGY**



Научный совет по проблеме «Физика полупроводников» Национальной Академии наук Украины, Министерство образования и науки Украины, Министерство промышленной политики Украины, Украинское физическое общество, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова

**проводят**

**2-ю Международную научно-техническую конференцию  
«Сенсорная электроника и микросистемные технологии»  
(«СЭМСТ-2»)**

**с выставкой разработок и промышленных образцов сенсоров  
Украина, Одесса, 26—30 июня 2006 г.**

**Научные направления конференции**

1. Физические, химические и другие явления, на основе которых могут быть созданы сенсоры.
2. Проектирование и математическое моделирование сенсоров.
3. Сенсоры физических величин.
4. Радиационные, оптические и оптоэлектронные сенсоры.
5. Акустоэлектронные сенсоры.
6. Химические сенсоры.
7. Биосенсоры.
8. Материалы для сенсоров.
9. Технологические проблемы сенсорики.
10. Сенсоры и информационные системы.
11. Деградация, метрология и аттестация сенсоров.
12. Микросистемные технологии (MST).

Оргкомитет «СЭМСТ-2»: НИЛ-3

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова; ул. Дворянская, 2, г. Одесса, 65026, Украина, тел./факс +38(0482)-23-34-61, +38 (048) 726 63 56, Лепих Ярослав Ильич  
E-mail: semst-2@ukr.net, semst-2@onu.edu.ua, ndl\_lepikh@mail.ru  
<http://www.onu.edu.ua/ru/conference/semst2.html>